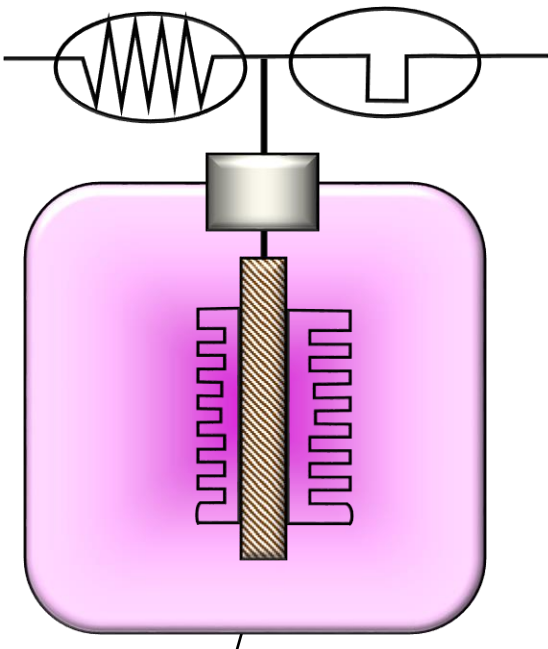
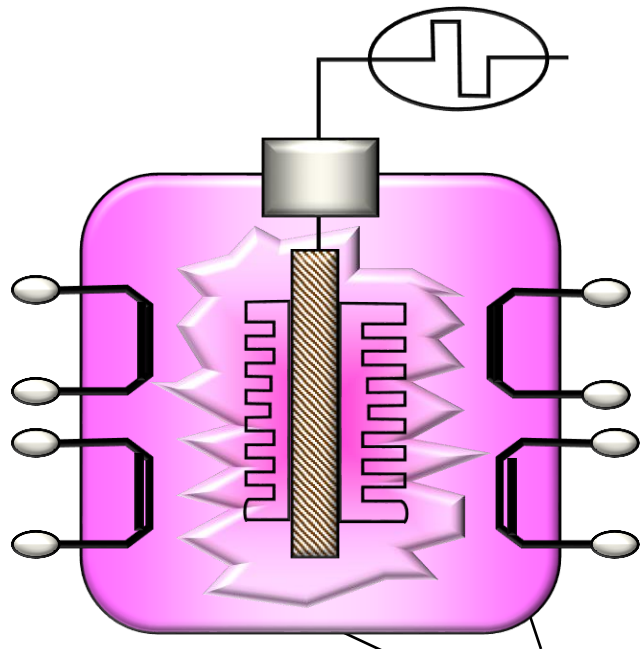


高速成膜PIAD装置

	PBIID方式	PIAD方式
<p style="writing-mode: vertical-rl;">プラズマによる表面改質方式の違い</p>	<p style="text-align: center;">高周波電源 負パルス電源</p>  <p style="text-align: center;">重畳式プラズマ発生・イオン源</p>	<p style="text-align: center;">正負パルス電源</p>  <p style="text-align: center;">13.56MHz 外部RFイオン源</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">特徴</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・高周波電源で基材周辺に均一に容量結合型プラズマを生成し、基材に負のパルス電圧を印加してプラズマ中の正イオンを基材に引き寄せ、基材にイオン注入及びDLC膜を形成する。マイクロ溝にも均一DLC成膜可能。 ・成膜速度: $0.8 \mu\text{m}/\text{時間}$ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワンターンコイル型高周波プラズマ発生源で基材周辺に誘導結合型高密度プラズマを生成し、基材に正負ないし負パルス電圧を印加して、プラズマ中の正イオンを基材に引き寄せ、基材にイオン注入及びDLC膜を形成する。マイクロ溝にも均一DLC成膜可能。 ・成膜速度: $5 \mu\text{m}/\text{時間}$